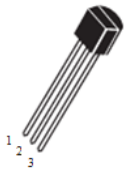
Yixin

S8050

NPN通用晶体管

Lead(Pb)-Free

TO-92



1.发射器
2.基
3.收集

绝对最大额定值（TA = 25℃ ）

等级	符号	价值	单位
集电极 - 发射极电压	VCEO	25	VDC
集电极 - 基极电压	VCBO	40	VDC
发射极 - 基极电压	VEBO	5.0	VDC
集电极电流	IC	500	MADC
器件总耗散T A=25 C°	PD	0.625	W
结温	Tj	150	°C
存储温度	TSTG	-55到+150	°C

电气特性

特征	符号	民	最大	单位
集电极 - 发射极击穿电压（ IC = 0.1 MADC ， IB = 0 ）	V（ BR ） CEO	25	-	VDC
集电极 - 基极击穿电压（ IC = 100 μAdc， IE = 0 ）	V（ BR ） CBO	40	-	VDC
发射极 - 基极击穿电压（IE = 100 μAdc， IC = 0 ）	V（ BR ） EBO	5.0	-	VDC
集电极截止电流（ VCE = 20伏， I B = 0 ）	ICE0	-	0.1	uAdc
集电极截止电流（ VCB = 40 VDC ， IE = 0 ）	ICBO	-	0.1	uAdc
发射极截止电流（ VEB = 3.0VDC ， I C = 0 ）	IEBO	-	0.1	uAdc

电气特性

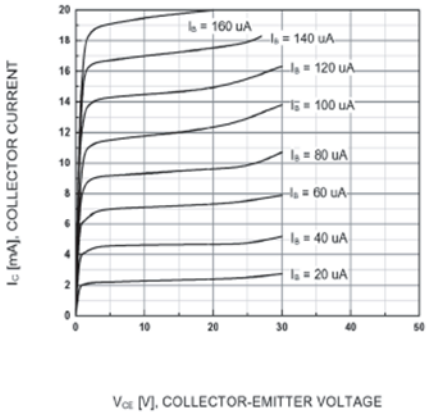
（ TA = 25℃除非另有说明） （ Countinued ）

特征	符号	民	典型值	最大	单位
基本特征					
直流电流增益 （ IC = 50 ADC， VCE = 1.0 V 直流）	的hFE（1）	85	-	300	-
直流电流增益 （ IC = 500 MADC， VCE = 1.0 V 直流）	的hFE(2)	50	-	-	-
集电极 - 发射极饱和电压 （ IC = 500 ADC， IB = 50 MADC ）	VCE （ SAT）	-	-	0.6	VDC
基射极饱和电压 （ IC = 500 MADC， IB = 50 MADC ）	VBE （ SAT）	-	-	1.2	VDC
电流增益带宽积 （ IC = 20 MADC， VCE = 6.0伏， F = 30MHz的）	fT	150	-	-	兆赫

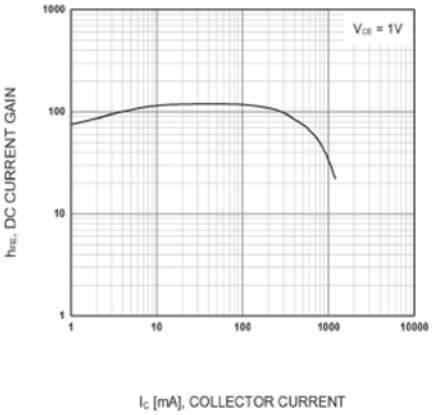
HFE分类（ 1 ）

秩	B	C	D
范围	85-160	120-200	160-300

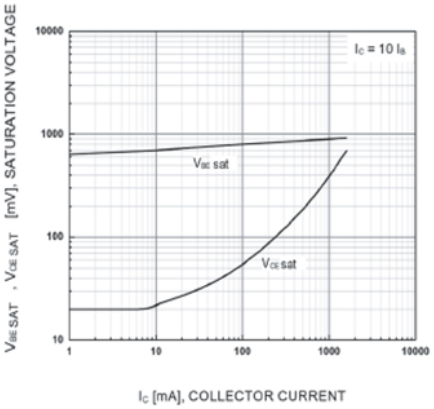
Typical Characteristics



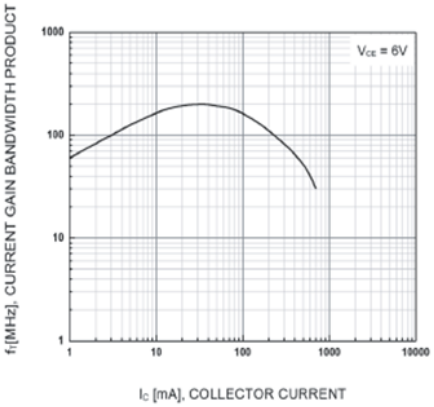
Static Characteristic



DC current Gain



Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage



Current Gain Bandwidth Product